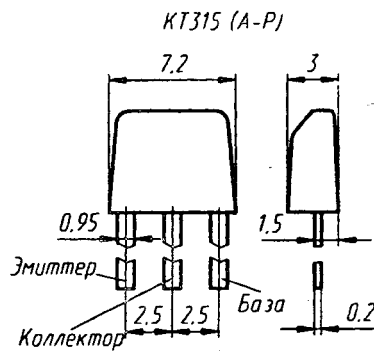


**КТ315А, КТ315Б, КТ315В, КТ315Г, КТ315Д,  
КТ315Е, КТ315Ж, КТ315И, КТ315Р**



Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры *n-p-n* усиленные. Предназначены для применения в усилителях высокой, промежуточной и низкой частоты. Выпускаются в пластмассовом корпусе с гибкими выводами. Тип прибора указывается в этикетке, а также на корпусе прибора в виде буквы соответствующего типоминимала.

Масса транзистора не более 0,18 г.

Изготовители — акционерное общество «Кремний», г. Брянск, Нальчинский завод полупроводниковых приборов, г. Нальчик, завод при НИИПП, г. Томск.

**Электрические параметры**

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при  $U_{кз} = 10 \text{ В}$ ,  $I_k = 1 \text{ мА}$ :

КТ315А, КТ315В ..... 30...120

|   |           |
|---|-----------|
| КТ315Б, КТ315Г, КТ315Е .....  | 50...350  |
| КТ315Д.....   | 20...90   |
| КТ315Ж.....   | 30...250  |
| КТ315И, не менее .....  | 30        |
| КТ315Р .....  | 150...350 |
| Граничная частота коэффициента передачи<br>тока при $U_{кз} = 10$ В, $I_k = 1$ мА, не менее .....                                     | 250 МГц   |
| Постоянная времени цепи обратной связи<br>при $U_{кб} = 10$ В, $I_3 = 5$ мА, не более:  |           |
| КТ315А .....  | 300 пс    |
| КТ315Б, КТ315В, КТ315Г, КТ315Р.....   | 500 пс    |
| КТ315Д, КТ315Е, КТ315Ж.....   | 1000 пс   |
| КТ315И.....   | 950 пс    |
| Граничное напряжение при $I_3 = 5$ мА,<br>не менее:   |           |
| КТ315А, КТ315Б, КТ315Ж .....  | 15 В      |
| КТ315В, КТ315Д, КТ315И .....  | 30 В      |
| КТ315Г, КТ315Е, КТ315Р.....   | 25 В      |
| Напряжение насыщения коллектор—эмиттер<br>при $I_k = 20$ мА, $I_б = 2$ мА, не более:  |           |
| КТ315А, КТ315Б, КТ315В, КТ315Г, КТ315Р  | 0,4 В     |
| КТ315Д, КТ315Е .....  | 0,6 В     |
| КТ315Ж.....   | 0,5 В     |
| КТ315И.....   | 0,9 В     |
| Напряжение насыщения база—эмиттер<br>при $I_k = 20$ мА, $I_б = 2$ мА, не более:   |           |
| КТ315А, КТ315Б, КТ315В, КТ315Г, КТ315Р  | 1 В       |
| КТ315Д, КТ315Е .....  | 1,1 В     |
| КТ315Ж.....   | 0,9 В     |
| КТ315И.....   | 1,3 В     |
| Обратный ток коллектора при $U_{кб} = 10$ В,<br>не более.....   | 1 мкА     |
| Обратный ток коллектор—эмиттер<br>при $R_{бз} = 10$ кОм, $U_{кз} = U_{кз, макс}$ , не более:  |           |
| КТ315А, КТ315Б, КТ315В, КТ315Г,<br>КТ315Д, КТ315Е, КТ315Р .....   | 1 мкА     |
| КТ315Ж.....   | 10 мкА    |
| КТ315И.....   | 100 мкА   |
| Обратный ток эмиттера при $U_{эб} = 5$ В для<br>КТ315А, КТ315Б, КТ315В, КТ315Г, КТ315Д,<br>КТ315Е, КТ315Ж, КТ315И, КТ315Р, не более.. | 50 мкА    |
| Входное сопротивление при $U_{кз} = 10$ В,<br>$I_k = 1$ мА, не менее .....  | 40 Ом     |
| Выходная проводимость при $U_{кз} = 10$ В,<br>$I_k = 1$ мА, не более .....  | 0,3 мкСм  |

Емкость коллекторного перехода

при  $U_{кб} = 10$  В, не более:

|   |       |
|---|-------|
| КТ315А, КТ315Б, КТ315В, КТ315Г,<br>КТ315Д, КТ315Е, КТ315Р ..... | 7 пФ  |
| КТ315Ж, КТ315И .....  | 10 пФ |

### Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор—эмиттер

при  $R_{бэ} = 10$  кОм:

|                              |      |
|------------------------------|------|
| КТ315А .....                 | 25 В |
| КТ315Б, КТ315Ж .....         | 20 В |
| КТ315В, КТ315Д .....         | 40 В |
| КТ315Г, КТ315Е, КТ315Р ..... | 35 В |
| КТ315И .....                 | 60 В |

Постоянное напряжение база—эмиттер .....

6 В

Постоянный ток коллектора:

|   |        |
|---|--------|
| КТ315А, КТ315Б, КТ315В, КТ315Г,<br>КТ315Д, КТ315Е, КТ315Р ..... | 100 мА |
| КТ315Ж, КТ315И .....  | 50 мА  |

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при  $T \leq +25$  °С:

|   |         |
|---|---------|
| КТ315А, КТ315Б, КТ315В, КТ315Г,<br>КТ315Д, КТ315Е, КТ315Р ..... | 150 мВт |
| КТ315Ж, КТ315И .....  | 100 мВт |

Тепловое сопротивление переход—среда .....

0,67 °С/мВт

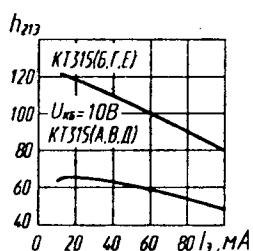
Температура р-п перехода .....

+120 °С

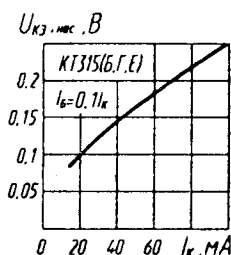
Температура окружающей среды .....

-60...+100 °С

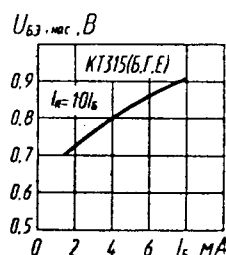
Допускается эксплуатация транзисторов в режиме  $P_k = 250$  мВт при  $U_{кб} = 12,5$  В,  $I_k = 20$  мА.



Зависимость статического коэффициента передачи тока от тока эмиттера



Зависимость напряжения насыщения коллектор—эмиттер от тока коллектора



Зависимость напряжения насыщения база—эмиттер от тока базы